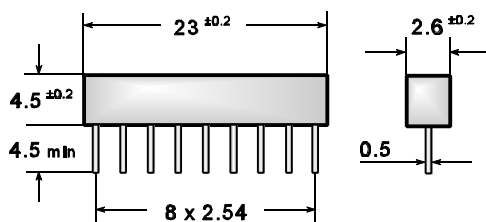


Rectifier Arrays
Gleichrichter Sätze


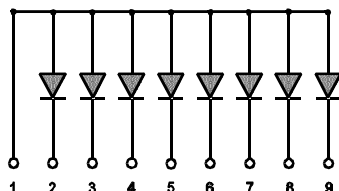
Dimensions / Maße in mm

Nominal power dissipation
Nenn-Verlustleistung 1.2 W

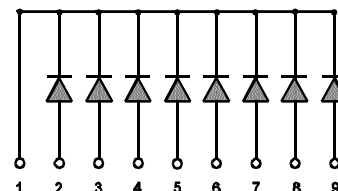
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung 100...1000 V

9 Pin-Plastic case
9 Pin-Kunststoffgehäuse 23 x 2.6 x 4.5 [mm]

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton Weight approx.
Gewicht ca. 0,6 g



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anode



"DA 811 K...8110 K": com. kathodes / gem. Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
DA 811 A/K	100	120
DA 814 A/K	400	480
DA 8110 A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load, $T_A = 25^\circ\text{C}$
 For one diode operation only $I_{FAV} = 600 \text{ mA}^1)$
 For all diodes together $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^1)$

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, $T_U = 25^\circ\text{C}$
 Nur eine Diode im Einsatz $I_{FAV} = 600 \text{ mA}^1)$
 Für alle Dioden zusammen $I_{FAV} = 150 \text{ mA}^1)$

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, $T_A = 25^\circ\text{C}$ $I_{FSM} = 30 \text{ A}$
 superimposed on rated load, one diode only
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
 überlagert bei Nennlast, für eine Diode

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	$1.2\text{ W}^{1)}$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$ $< 90\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85\text{ K/W}^{1)}$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden